

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-22463

(43)公開日 平成10年(1998)1月23日

(51)Int.Cl. <sup>b</sup>	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 01 L 27/10	4 5 1		H 01 L 27/10	4 5 1
27/04			27/04	C
21/822				E
27/108			27/10	6 5 1
21/8242			29/78	3 7 1

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 7 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平8-172532

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(22)出願日 平成8年(1996)7月2日

(72)発明者 ニコラス ナーゲル

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
一株式会社内

(72)発明者 香取 健二

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
一株式会社内

(74)代理人 弁理士 佐藤 隆久

(54)【発明の名称】 積層構造及びその製造方法、キャパシタ構造並びに不揮発性メモリ

(57)【要約】

【課題】ヒロックの発生を可及的に抑制することができる積層構造及びその製造方法、その積層構造を用いたキャパシタ構造、及びそのキャパシタ構造を用いた不揮発性メモリを提供する。

【解決手段】下地層2の上にバッファー層3を介して電極層4を設けた構造において、バッファー層3として、金属部分酸化物を用いる。金属部分酸化物として、Ti<sub>1-x</sub>O<sub>x</sub> (x = 0.2 ~ 0.6) が好ましい。

